



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

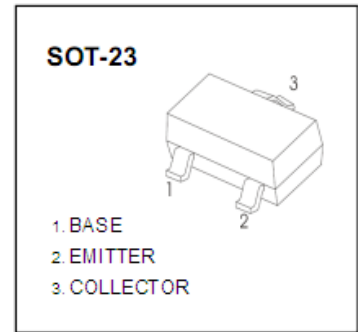
2SA1362 (PNP)

特点/Features :

饱和压降小 ;

用途/Applications :

用于低频功率放大电路或开关电路。



极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-10	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-15	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	-0.8	A
基极连续电流/Base Current Continuous	I_C	-0.16	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.2	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	$I_C=-10mA, I_B=0$	-15			V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-15V, I_E=0$			-0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V, I_C=0$			-0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1V, I_C=-100mA$	120		400	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1V, I_C=-800mA$	40			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-400mA, I_B=-8mA$			-0.2	V
基极-发射极饱和压降	V_{BE}	$V_{CE}=-1V, I_C=-10mA$	0.5		-0.8	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=-5V, I_C=-10mA$		120		MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$		13		pF

印章/Marking & h_{FE} 分档/Classification of $h_{FE(1)}$

范围/Range	120~240	200~400
印章/Marking	AEY	AEG



典型特性曲线图/Typical Characteristics

